```
1990:181099 CAPLUS
          AN
               112:181099
          DN
          ED
               Entered STN: 12 May 1990
          TI
               Heatproof epoxy resin compositions for potting of
               semiconductors
          IN
               Tanaka, Masayuki; Ueno, Toshiaki; Takuwa, Shiro
          PΑ
               Toray Industries, Inc., Japan
          SO
               Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 7 pp.
               CODEN: JKXXAF
          דת
               Patent
               Japanese
          LΑ
          IC
               ICM C08G059-42
               ICS C08G059-62; C08G063-00; C08K007-16; C09K003-10; H01L023-30
          CC
               38-3 (Plastics Fabrication and Uses)
               Section cross-reference(s): 37, 76
          FAN.CNT 1
               PATENT NO.
                                 KIND DATE
                                                      APPLICATION NO. DATE
NO TRANS
               JP 01245014
                                 Α2
                                       19890929
                                                      JP 1988-72984
                                                                       19880325
          PRAI JP 1988-72984
                                       19880325
               Title compns. contain epoxy resins, hardeners, fillers
               contg. .gtoreq.50% fines (particle size .ltoreq.14 .mu.m), and compds
               contg. .gtoreq.3 OH groups at 3 adjacent positions of an arom. ring.
              mixt of o-cresol novolak epoxy resin (
               epoxy equiv 200) 12.9, phenol novolak (OH equiv 107) 7.0,
               1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 0.3, carnauba wax 0.2, brominated
               phenolic novolak epoxy resin (epoxy
               equiv. 270; 36% Br) 2.8, Sb203 1.5, carbon black 0.2, (3-
               glycidoxypropyl)trimethoxysilane 0.6, fused silica (89% .ltoreq.14-.mu.m
               particles) 74.0, and pyrogallol 0.5 part was transfer molded as a potting
               compn., and cured 5 h at 180 degree. Aging 72 h at 85 degree. and 85%
               relative humidity and contact with a solder bath for 10 s caused 0 cracks
               in 20 samples, vs. 3 without pyrogallol.
               heat resistance epoxy potting; potting epoxy resin
               polyol; pyrogallol epoxy resin potting; hydroxy compd
               epoxy potting; solder resistance epoxy potting
          ΙT
               Potting compositions
                   (epoxy resins, contg. arom. polyhydroxy compds.)
601/11
          IT
               Epoxy resins, uses and miscellaneous
               RL: USES (Uses)
                   (potting compns., contg. arom. polyhydroxy compds.)
          IT
                                                                121-79-9, Propyl gallate
               87-66-1, Pyrogallol
                                    99-24-1, Methyl gallate
               149-91-7, Gallic acid, uses and miscellaneous
3,1,5-trihydnoxy
                                                              1083-41-6. Butvl
               gallate
                        1087-26-9, Hexyl gallate
  benzoic acid
               RL: USES (Uses)
                   (epoxy resins contg., for potting)
               60676-86-0, Fused silica
          ΙT
               RL: USES (Uses)
                   (fillers, epoxy resin contg., for potting)
```

RN149-91-7 REGISTRY CN Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI) (CA INDEX NAME) OTHER CA INDEX NAMES: CN Gallic acid (7CI, 8CI)
OTHER NAMES: CN (3,4,5-Trihydroxybenzoic acid CN NSC 20103 CNNSC 674319 FS 3D CONCORD MF C7 H6 O5 CI COM LCSTN Files: ADISNEWS, ANABSTR, CA, CAOLD, CASREACT, CHEMLIST, CIN, CSCHEM, CSNB, HODOC*, IFICDB, IFIPAT, IFIUDB, MEDLINE, PS, RTECS*, SYNTHLINE, TOXCENTER (*File contains numerically searchable property data) Other Sources: DSL**, EINECS**, TSCA** (**Enter CHEMLIST File for up-to-date regulatory information)

PROPERTY DATA AVAILABLE IN THE 'PROP' FORMAT

6690 REFERENCES IN FILE CA (1907 TO DATE)

447 REFERENCES TO NON-SPECIFIC DERIVATIVES IN FILE CA

6698 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1907 TO DATE)

19 REFERENCES IN FILE CAOLD (PRIOR TO 1967)

DERWENT-ACC-NO:

1989-328795

DERWENT-WEEK:

199720

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Resin compsns. for sealing

semiconductors - contq.

epoxy! resins, hardeners and powder

fillers contg. fine

powders and hydroxyl gp.-contg. cpds.

PATENT-ASSIGNEE: TORAY IND INC[TORA]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0072984 (March 25, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC September 29, 1989

N/A

JP 01245014 A 007

N/A

JP 2600258 B2

April 16, 1997

N/A

006

C08G 059/62

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 01245014A

N/A

N/A

1988JP-0072984

March 25, 1988

JP 2600258B2

1988JP-0072984

March 25, 1988

JP 2600258B2

Previous Publ.

JP 1245014

N/A

INT-CL (IPC): C08G059/42,

C08G059/42, C08G059/62, C08G063/00,

C08K003/00 ,

C08K007/16 ,

C08L063/00 , C09K003/10 , H01L023/29 ,

H01L023/30 ,

H01L023/31

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01245014A

BASIC-ABSTRACT:

Resin compsns. for sealing of semiconductors contain (A)

epoxy resins, (B) hardeners and (C) powder fillers contg. at least 50 wt.% of fine powders having a granular dia. of below 14 microns as main components and 0.001-20wt.% of (D) cpds. contg. at least 3 OH gps. being adjacent to aromatic rings and opt. cong.substits other than OH qp.

Pref. (A) and (B) contain impurities e.g. Na ion, C1 ion, free acids and alkalis. (A) and (B) are used in amts. of 3-30 wt.% (5-25wt.%) and 1-20 wt.% (2-15 wt.%), respectively, at a chemical equiv. ratio of (B) to (A) being 0.5-1.5 (0.7-1.3). As (C), fused silica lowering coefft. of linear expansion is pref. used. (C) is used in amts. of 50-85 wt.% (65-80 wt.%). (D) are pyrogallol, Gallic acid and their derivs.

USE/ADVANTAGE - The resin compsns. are used for sealing of semiconductor devices. The resin compsns. have good soldering heat resistance and then prevent cracking of resins in the process of soldering for sealing of semiconductors.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: RESIN COMPOSITION SEAL SEMICONDUCTOR CONTAIN POLYEPOXIDE RESIN

HARDEN POWDER FILL CONTAIN FINE POWDER HYDROXYL GROUP CONTAIN

COMPOUND

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03 U11

CPI-CODES: A05-A01E2; A08-R01; A12-E04; A12-E07C; L04-C20A;

EPI-CODES: U11-A07;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0539U; 1527U ; 1694U ; 5085U ; 5087U ; 5222U

の日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-245014

Dint, CL.	織別記号	庁內整理番号	魯公開	平成1年(1989)9月29日
C 08 G 59/42 59/62 63/00	NHY NJF NLD	7602—4 J 7602—4 J 6904—4 J		
C 08 K 7/16 C 09 K 3/10 H 01 L 23/30	CĀM	L-7215-4H R-6412-5F審查請求	朱請求 言	請求項の数 1 (金7页)

②特 職 昭63-72984

❷出 頭 昭63(1988)3月25日

愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東レ株式会社名古 勿発 明 屋事業場内 愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東レ株式会社名古 秋 麫 ②発 駶 上 屋事業場内 愛知県名古屋市港区大江町9番池の1 東レ株式会社名古 多久和 志郎 ②発 屋事樂場内

が出 頭 人 東 レ 株 式 会 社 東京都中央区日本機監町2丁目2番1号

哟 組 异

1、発明の名称

半導体對止用樹脂組成物

2.特許額求の範囲

本本年シ祖監(A)、硬化制(B) および粉末状 充填剤(C) を主成分とする半準体對止用機關組成物中に、 設予単に3個以上の機投した水酸基を有し、か つ該水酸基以外の震機基を有するか。また、は有 しない化合物(D) を0.001~20度量%合有 し、かつ前記粉末状充填制(C) が粒子後14月 以下の機粉末粒子を50重量%以上含有することを特徴とする半導体對止用機能組成物。

3、売明の詳細な説明

く蔵様上の利用分野>

水発明は単等体装置を封止するための動脂種 紋物に関する。さらに詳しくは、樹脂封止型半 導体装置を実践する際、ハンダ行け工程におい て封止保険にクラックが発生するのを防止した 学等体料止用動脂組成物に関する。

く従来の技術>

近年、半導体装造の高熱量度化が急速に進められており、乗子サイズの大型化と関集の微紀 化が著しく遊展している。これら高集張化された半導体装置も含め半等体装置は現在ほとんど が関島到止されているが、これは高類性の高い 優れた性能を有する到此用期間の開発に負うと ころが大きい。

一方、裁述は、アリント器収へのお品英装においても高密度化、自動化が進められており、登楽のリードピンを基板の穴に挿入する"移入する"移入する"移入力"がある。を表現表面に都品をハング行けする"表面実践方式"がさかんになってきている。それに伴い、バッケージも低米のDIP(デュアル・インライン・バッケージ)型から高度選集、表面実践に造した源型のPP(フラット・プラスチック・バッケージ)型に移行しつつある。

- 表面実装方式への移行に伴い、従来あまり間

特丽平1-245014(2)

思とならなかったハンダ付け工程が大きな問題となってきている。従来のピン婦入実践に対する。 はハンダ付け工程はリードががかかにはパッケーが表現に投がしたが、表面実施方式ではパッケーが表現に投がした。 カガにおけるハンダ付け方法としてはハンダ治 でおったが、もれかが、としてはかが、の地名が、いずれの相談のフローを全にかが、 かが、いずれの方法ではかかなことにパッケーがとしてのできないがないが、できたのが、 210~270での高温に加熱で対ししたパッケージはハンダ付け時に関節が分にいったが、かが、かが、またの対象に対する。 たっぱい、が、いずれの方法に加熱で対したパッケージはハング付け時に関節が分にいったが、からに、 物として使用できないという問題がおきる。

ハンダ付付工程におけるクラックの発生は、 後硬化してから実装工程の間までに吸湿された 水分がハンダ付け加熱時に爆発的に水蒸気化、 膨脹することに起因するといわれており、その 対策として後硬化したパッケージを完全に軽燥 し増到した容器に収納して出荷する方法が用い

本発明の目的は、かかるハンデ付け工程で生 ともクラックの問題を解消した改良された対応 用機能を提供することにあり、表面実験ができ る機能対止半導体装置を可能にすることにある。 <課題を解決するための手段> SATUS.

對止用週間の改兵も種々核對されている。たとは、對止用週間にゴム成分を配合し内部の方を低下させる方法(特別明58-219218号公報、特別明59-96122号公報)、無機先與新の品額を選択する方法(特別明58-19136号公報、特別明60-202145号公報)、無機免疫、利の形状を確認を担したり、かずみを均一化させる方法(特別明60-171750号公報、特別昭60-171750号公報、特別昭60-171750号公報、特別昭60-171750号公報、特別昭60-171750号公報、特別中での未分による認力発生を下げる方法(特別明60-65023号公報)などがある。

く発明が解決しようとする課題>

しかるに乾燥パッケージを容器に封入する方 法は製造工程および製品の取扱作業が設準になるうえ、製品価格がきわめて高値になる欠点が ある。

すなわち水売明はエボキシ物路(8)、硬化期(8) および粉末状充填剤(C)を主成分とする學業体料止用制器級成物において、蘇學學体對止用制體組成物において、蘇學學体對止用制體組成物中に、芳香類に3個以上の際接した水酸延を有し、かつ該水酸至以外の置減延を有するか、または有しない化合物(8)を0.001~20重量%含有し、かつ前記粉末状充填剤(C)が粒子を14年以下の微粉末粒子を50重%以上含有することを特成とする學學体對止用開始組成物である。

以下、本発明の構成を詳述する。

本発明の単導体対止用機器超減物はエポキシ 樹脂(A)、硬化物(B) および粉水状充質剤(C) を主境分として食有する。

本発明におけるエポキシ樹脂(A)は、1分子中にエポキシ基を2個以上寄するものであれば特に限定されない。

たとえば、クレゾールノボラック型スポキシ 側胎、フェノールノボラック型スポキシ値流、 ビスとドロギシビフェニル型スポキシ機器、ビ

特開平1-245014(3)

スフェノールA型エボキシ圏胎、梭状脂肪狭工 ボキシ協能、脂環式エボキシ樹脂、複業環ズエ ボキシ樹脂、ハロゲン化エボキシ樹脂、スピロ 環合有エボキシ樹脂などが挙げられる。

これらのエポキシ製能は2種類以上併用して もよい。

本発明の閲覧組成物においてはボウシ膨脂(A) の配合量については特に制限はないが、通常は 3~30重量%、好ましくは5~25重量%で ある。

本発明における硬化剤(8) はまだキシ歯脂と 反応して硬化されるものであれば特に限定され ない。たとえば、フェノールノボラック機能、 クレゾールノボラック樹脂、下記式面で表わされるノボラック樹脂、

(ただし、nはO以上の数数を示す。)ビスフェノールAやレゾルシンから合成され

特に影ましくは10点以下の微物水粒子を50 重量%以上含有することが必須である。14点 以下の戦務水粒子が50重量%水準の場合はハ ンダ工程におけるクラックの発生防止効果は十 分発揮されない。

物来状充填削(c)の材質に関しては特に制限がないが、過度は溶散シリカ、結晶シリカ、アルミナ、選化ケイ業、放化ケイ素、及放ウス、アシカ、以前カルシウム、以化ケクンなどができるが、カルシウム、設化ナタンなどができるがある。なかでも複数シリカは線膨脹係数を低下させるが表現したもの機能はなく、過常は変数のものの、競技のものはたは酸砂状を倒用したものとができる。

粉水状充填剤(C) の粒度分布に関じても、粒子値が上記の範囲内にあるかぎり特な割線はない、異なる粒度分布を持った物末状充填削を2

る各種ノボラック切断、各種多価フェノール化合物、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水でレイン酸、無水フタル酸、無水ピロメリット酸などの酸酸水物、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルスルボンなどの芳香度アミンなどが挙げられるが、特に爆算されるものではない。

本発明の倒端機成物において硬化剤(B)の配合量については特に制顔はないが、通常は1~20歳量%、好ましくは2~15乗量%である。

本発明で使用するエポキシ組織(A) および硬化剤(B) は制湿性の点からナトリウムイオン、 塩素イオン、遊離の数、アルカリやそれらを生成する可能性のある不純物はできるだけ除去し たものを用いることが発ましい。

エボキシ製鋼(A) と硬化剂(B) の配合比は、 機械的性質や耐熱性などの点からエボキシ樹脂 に対する硬化剤の化学当量比が0.5~1.5、特に0.7~1.3の範囲にあることが打ましい。

本発明の樹脂組成物における粉末状光染例(C)は粒子径が14以製下、鮮ましくは12以以下、

趙以上併用することもできる。

本発明の樹脂程度物において、粉末状充填解 (E) の配合量は、過常50~85重量%、好ま しくは65~80重量%である。50重量%水 満では線財服係数が大きくなり、85重量%を 想えると成形像が不十分である。

特問平1-245014(4)

また、本残明において、エボキシ樹脂と硬化 別の硬化皮心を促過するために硬化促進剤を用いてもよい、硬化促送剤としては硬化反応を促 進させるものならば特に限定されない。たとえば、2-メチルイミダゾール、2-フェニルイ

実施的中、部数と光はそれぞれ重量部と重量 光を窓味する。

実施例1~17、比較例1~13

報』に示した版料、後2に示した充填割および表3に示した各種の化合物(5)を表3に示した各種の化合物(5)を表3に示した配合処方の利成比で配合し、ミキサーによりドウイブレンドした。これをロール表面温度90℃のミキシングロールを用いて5分間加熱温線したのち、冷却、特砕して樹脂組成物を製造した。

これらの衝崩組成物と複数索子を掲載した4 2アロイ製リードフレームを用い、低圧トラン スファー成形機により180℃×2分の乗作で 44ピンフラットパッケージを成形し、次いで 180℃で5時間後硬化した。

待られたフラットバッケージ硬化物を83℃、83%RHで72時間加湿処理したのち、260℃のハンダ沿に10秒間減渡し、浸潤後のクラック発生状況を調べた。

結果を表るに示す。

ネダゾールなどのイミダゾール類、ペンジルジメチルアミン、1.8ージアザビシクロ (5.4.0) ウンデセンー7 (DBUと略す) などのアミン類、トリフェニルポスフィン、テトラフェニル ホルホニウム、テドラフェニルボレートなどの お願りン化会物などが好ましく用いられる。

本発明の側指程の物は必要に応じてシリコーンゴム、オレフィン系ゴム、ジエン系ゴムなどのゴム状置合体、ワックスなどの経型剤、カーボンブラックなどの特性剤、カップリング制、 鼻液化化合物、酸化アンチモンなどの難熱剤、 シリコーンオイルなどを用いることができる。

本発明の製脂組成物は溶液混練することが好ましく、溶脂混雑は公知の方法を用いることができる。たとえばパンバリーミキサー、ユーダー、ロール、一幅もしくは三軸の抽出機、コエーダーなどを用い溶融温標することができる。
<実施例>

以下、実施例により本売明を具体的に説明する。

表3においてハンダ耐熱性をパッケージ20個 中クラックが発生しなかったパッケージの個数 で表示した。

時開平1-245014(5)

荻 .

	*			Ťá	;							P3					客	
工	∄*	#		,	栩	膽	エポキ	シ	5 🖳	2 (00	クオリ	7	クレ	7 -	ルノボラック型	エポキシ樹脂	
酥			Ł		- +	719	水税基	귞	t 1	0 7	o)	7 34. /	· — į	v j	ボラ	ック協所		
硕	化		æ	31	.	剂	1,8-	327	, 4jt.	– t	25%) 12 -	- (:	5, 4,	0.)	ウンデセンー?	(DBU)	
離			₹.	11.10		75	n n	- 1)) *{	ァ	- y	2	ス				. <u> </u>
触			繫			M	工术书	シミ	5 <u>A</u>	2 7	70.	庚 3	含	t 3	6%	の臭素化フェノ	ールノポラック	エボキン側脂
贱		燃.		助		減	三战	i	Ł	7	ン	*	₹	ν				
梅			色			村	ガ ー		K	····	ブ	ラ	7	7				
カ	Ŋ	ブ	ij	×	7	剂	0-7	'y :	レド	45 5	· 7 :	2 L /	▶ ▶ □) x	ト ≠	シシラン		
ŝ⁄	y .		_	ン	z'	Д,	ポリジ	٠,١٠	+ jl	シロ	2 47 1	ナング	の便4	比物	水份	(粉末平均粒径	5 µ m }	

*** 2**

		-4- 4-	.								~		į		粗(圣 分	布 (是	R 模 盤	1 %)	
70) <i>:</i>	* 祆	龙竹	Į AI			M ——					#		[6 #	8 #	10 m	15.44	(A _{fii}	18 μ	يبر 20
禿	Ą	孙	A	礟	Ħ	农	iff	at	. 1	. 1	R	粉	赤	69	78	83	8.6	8.9	9 2	95
亢	林	押	θ	鉄	聊	łŁ	iff	Fir	; \$\sigma	1	*	粉	*	41	48	53	57	63	66	70
充	4	飙	Ċ	畉	41	뫇	W	ile	<u>-</u>	IJ	#	80	寒	36	4.2	49	53	58	5 4	6.8
先	M	捌	D.	敏	神	秋	#1	X4	2	. ,	#	郡	*	3 0	3.6	41	49	54	59	6 4
—— 克	猁	刑	E	觐	Þ	4.	褶	ME	٠ ۽	·	20	7 0	94	23	3 1	36.	39	47	50	5 5
充	埃	PP	P	較	F¢.	状	襧	N.	<u>.</u>	,) j	10	*	2 2	28	33	3 6	4 3	47	51
光	卓	m	G	練	숛	消	ŗ	Aè	٠	ij	力	83	末	28	35	4 4	5 3	5 9	68	74
充	邶.	ħ	H	增	状	泊		ÄĖ	シ	ij	カ	\$)	來	1 2	17	18	20	2.3	26	43
尤	42	A	ī	鬼鬼	填墙			A P	4	0	基	2	% %	4 !	4 2	53	56	61	6 5	69
充	-10	利	J	光光	填鍊	नै	-	C H	7	0	整整	量	% %	3 4	40	48	53	58	6.5	70
充	49	剤	к	充光	類	#	4	A	6		盤	庄	% %	4 6	54	57	60	63	6.6	74

時間平1-245014(6)

表 3 (その1)

	and a second	实机例)	突旋剪2	奖施例 3	実 維 例 4	实验例5	実動到 6	奥维例?	実錐例8	実施例り	実施例10
	エポキシ 御扇	12.9	12.9	12.9	129	12.9	12.9	12.6	1 9.9	1 2.1	12.6
	果 化 制	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	6.4	5.3	5.3
ðZ.	硬化促进剂	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0,3	0.3
	雅 数 初	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2	0.3	0.2	0.2
e e	非 微 和	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	28
137 	姓無明期	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	老 色 削	0.2	0,2	0,2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2
90%	カップリング制	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202	マローニロイ	0	0	0	0	•	•	3.0	3.6	3.0	ø
力	物末状充填制	光 獎 耐 A 74.0	宠 典 耐 A 74.0	完集 耐 A 74.0	充填房 D 74.0	完與制度 74.0	克迪利 B 74.0	充填制 B 71.0	71.0	龙城前 € 71.0	近 师 利 D 75.0
"	化合物 (8)	ピロガロール 0.5	没 年 于 故 〇.5	後東予酸1年2 0.5	60.5	(2.5 (2.5	没女子数4% 0.5	ਇਹ#ਧਾ⊸# 0.3	後食子餅 1.0	2.0 Tights	₩¤##=/₽ 1.6
	⊕ #	100.0	100.0	100,0	100.0	1 00.0	100.0	1 60.0	100.0	100.0	1 00.G
(M.)	ング耐熱性ナージ2の間切りがかり生しかいファンジの振数	20	20	20	2 0	19	17	18	20	20	20

配合地方の数字は重量部を振す。

表 3 (その2)

****	~***	••••	~~~	~~~		斑鸠例11	完良例12	実施例13	実施例14	実施例 1.5	実施的しる	実験例17	此數例1	比較例2	此較明3
	Ī	- 41	· a	5	85 F2	10.0	13.2	16,4	11.25	14.2	11.29	11.2	13,2	13.2	13.2
82		!		iŁ	211	5.4	7.1	8.9	6.1	7,7	6.1	6.0	7 .2	7.2	7.2
	₩.	化	. 0	建地	刑	0.3	9.3	. 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0,3
i	×		į	2	Ħ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
合	焳			z t	艄	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2,8
a	苁	;	類	80	嗣	1.5	1.5	1.5	1.5	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
•	#		1	3	渺	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2	0.2	0.2
905. İ	ņ	(بود	プ	リン	夕 初	0.6	0.6	0.6	0.6	0,6	0.3	0,6	0.6	0.6	0.6
ALE .	シ	9	3	- v	<i>4</i> L	0	4.0	4.0	5,0	5,0	5,0	5.0	0	. 0	3.0
方	150	末	栿	充	筑酮	尤斯制 1 78.9	光南刻 1 79,0	充填削 T 65.0	充购剂 J 72.0	光典削。 67.0	光 및 刻 K 72.0	充具前K 72.0	光 및 斯 A 74.0	宏築剂 B 74.0	光模湖 C
"	ıŁ	1	•	籼	tD)	政政子款 1.0	改 全 子 款 0.1	松本7数 2 + 6 0.1	ピロガロール 0.05	法 由 Y做2 5 6 0.5	사-교육대기 0.0 l	准 余 子 酸 0.2		-	
		â	-	1	t	100.0	1 00.0	100.0	100.0	1 00.0	100.0	1 00.0	100.0	1 00.0	0,00 1
(f)	y = } E14	70	西	9	(本)	20	18	17	17	18	15	17	3	3	2

配合処方の数字は食量がを示す。

詩開平1-245014(ア)

異 3 (その3)

	···		_	<i>س</i> ے.			起觀照4	比較例5	进载的6	北敦网?	免数例8	比级的分	建物的10	比較例1!	比較例12	比較例1:
	, z	i, 13	: :	ķ s	. #	爲	10.6	19,3	12.9	12,9	12.6	12,1	10.0	16.4	13.2	13.3
和	e e	•		łŁ		M	5.8	7.1	7.6	7,0	7.5	6.3	5.4	8,9	7.2	7.1
f IL	8	(1	Ł.	Œ j	t	ij.	0,\$	0.3	0.3	0.3	0.3	0,3	0.3	0,3	0.3	0.3
	Af	t 		Ø		削	0,2	0.2	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2	0.2	0.2	0.2
â	24			燃		Яij	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
"	维	ţ 	含	F	۷r 	39)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1,5	1.5
	47	ł .		色		AI	0,2	6.2	0,2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
tore.	# 	*	7	IJ;	1	Αij	0.6	0.6	0.6	0,6	0.6	0,3	0.6	0,6	0.6	0.6
/*÷	3	ij	ש	- :	× 33	· <u>-</u> ,	0	4.0	0	O.	3.0	30	0	4,0	0	4.C
y _F	ŧ	*	¥	jt j	ışı	刑	文 44 利) 78.0	充填剂 [70.0	元 和 M E 74.0	74,0	71.0	71.0		65.0	充填剂 B 74.0	光 疫 药 F 76.0
	Æ.		#	物	(95		· -	ピ ወ∄ છ−ル 0.3	程度子数 0.5	ರದನ್ನು,⊬ 0.3	花盆7世700 2.0	没女子做 1.0	没在了数44 0.1	-	-
_		É			Aŕ		100.0	100.0	100.0	1 00.0	1 0 0.0	100.0	100.0	1 00.0	1 00,0	1 00.0
7(+) JE 4	, }-} El@	5 2 () (1)	7 000 - 4 4	100	特が開発	5	2	i	4	4	2	5	1	,	o	G

配合処方の数字は遺量部を示す。

表3の結果から次のことが明らかである。

実施図1~17にみられるように化合物(D) き含有し、かつ物水状充類削が数子経14以以 下の微弱水状粒子を50重量%以上含有する水 発明の側隔組成物で封止したパッケージは、8 5で/85%RHで加湿処理後260でのハン が海に浸漉してもほとんどクラックが発生せず、ハンダ副熱性が優れている。

一方、比較例1~5 にみられるように、既粉束状光型削が14 A 以口下の散粉束粒子を50 質量%以上含有したとしても、化合物(0) を含有しない制度組成物はほとんどのバッケージにクラックが発生する。

比較例6~11にみられるように化合物(0) を含むしても、静水状光凝剤が粒子径14以以下の歌物末粒子を50重星光来消しか含有しない切解組成物はほとんどのパッケージにクラックが発生する。

比較例12、13にみられるように、化合物(0)を含有せず、粉寒状光波剂が数子繰14以

以下の敵の牝粒子を50重量%未満しか合有しない機能組成物はすべてのパッケージにクラックが発生する。

く発明の効果>

本発明の樹脂組成物はハンダ耐熱性がきわめて 優れており、本発明の樹脂組成物で対止することにより 半導体装置を実装する酸のハンダ付け工程における樹脂クラックの発生を助止することができる。この特徴をいかして、表面実践 用の半季体装置の割止など罹々の用途への応用 が期待される、

特許出版人 車 レ 株式 会 往

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成7年(1995)10月9日

【公開番号】特開平1-245014

【公開日】平成1年(1989)9月29日

【年通号数】公開特許公報1-2451

【出願番号】特願昭63-72984

【国際特許分類第6版】

COSL 63/00 NLD 8830-4J

CO8K 5/04 NKZ 7242-4J

7/00

H01L 23/29

23/31

[FI]

H01L 23/30

R 8617-4M

手統 補正書



平成 年 月

特許庁長官 高 島 章 殿

1. 事 件 の 表 元

昭和63年特許顯第 72984号

2. 雅 明 の 名 称

半導体封止用樹脂組成物

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区日本領軍町2丁目2番1号

名称 (315) 東レ株式会社

代表取締役社長 前 田 勝 之 助



4. 補正命令の日付

白発

5. 補正により増加する請求項の数 なし

· 6. 補 正 の 対 像 明細書の「発明の群糊な説明」の棚

7. 補 正 の 内 容



(1) 明細書第6頁第20行

「ピスヒドロキシピフェニル型エポキシ樹脂」を、

「4.4 ーピス(2.3ーエポキシブロポキシ) -3,3,5,

5 ´ ーテトラメチルビフェニル等のビスヒドロキシビフェニル型エポキシ 樹脂 |

上緒エナス

(2) 明細書第12頁第16行

「抽出機」を「押出機」と補正する。